





## 19 BUNDESREPUBLIK **DEUTSCHLAND**



**PATENT- UND MARKENAMT** 

## **® Offenlegungsschrift**

<sub>®</sub> DE 100 43 204 A 1

(a) Aktenzeichen:

100 43 204.2

② Anmeldetag:

1. 9.2000

(3) Offenlegungstag:

4. 4. 2002

(f) Int. Cl.<sup>7</sup>: H 01 L 51/20

> H 01 L 51/40 H 01 L 51/10

(7) Anmelder:

Siemens AG, 80333 München, DE

(72) Erfinder:

Bernds, Adolf, 91083 Baiersdorf, DE; Clemens, Wolfgang, Dr., 90617 Puschendorf, DE; Fix, Walter, Dr., 90762 Fürth, DE; Rost, Henning, Dr., 91056 Erlangen, DE

⑤ Entgegenhaltungen:

198 51 703 A1 WO 99 10 939 A2

wo 97 18 944 A2

grated circuits" in "Applied Physics Letters", 73 (1998) 1, pp. 108-110; LIDZEY, D.G. et al.: "Photoprocessed and micropatterned conjugated polymer LEDs" in "Synthetic Metals" 82 (1996), pp. 141-148;

DRURY, C.J. et al.: "Low-cost al polymer inte-

XIANG-YANG, Zheng et al.: "Electrochemical Patterning of the Surface of Insulators with Electrically Conductive Polymers\* in "J.Electrochem.Soc.", 142 (1995) 12, pp. L226f.; KOBEL, W. et al.: "Generation of micropatterns in Poly(3-Methyl-Thiophene) films using microlithography: a first step in the design of an all-organic thin-film transistor" in "Synthetic Merals", 22 (1998), pp. 265-271; ANGELAPOULUS, M. and SHAW, J.M.: "In-Situ Radiation Induced Doping" in "Mol.Cryst.Lig-

Cryst.", 189 (1990), pp. 221-225;

## Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

(A) Organischer Feld-Effekt-Transistor, Verfahren zur Strukturierung eines OFETs und integrierte Schaltung

Die Erfindung betrifft einen organischen Feld-Effekt-Transistor, ein Verfahren zur Strukturierung eines OFETs und eine Integrierte Schaltung mit verbesserter Strukturierung der Funktionspolymerschichten. Die Strukturierung wird durch Einrakeln des Funktionspolymers in eine Formschicht, in der zunächst durch Belichten Vertiefungen erzeugt wurden, erzielt.



BEST AVAILABLE COPY